

Билет 10

1. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.

На основании своих исследований Резерфорд в 1911 г. предположил ядерную (планетарную) модель атома. Вокруг положительного ядра, имеющего заряд Ze (Z – порядковый номер элемента, e – элементарный заряд), размер 10^{-15} – 10^{-14} м и массу, практически равной массе атома, в области с линейными размерами порядка 10^{-10} м по замкнутым орбитам движутся электроны, образуя электронную оболочку атома.

Первый постулат Бора (постулат для стационарных состояний) : в атоме существуют стационарные состояния (не изменяющиеся со

стационарные состояния (не изменяющиеся со временем) состояния, в которых он не излучает энергии. Стационарные состояния атома соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны. Движение электронов сопровождается излучением электромагнитных волн. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные квантовые значения момента импульса, удовлетворяющие условию $m_e v r_n = \hbar n$ ($n=1, 2, 3...$) где m_e - масса электрона, v - его скорость по n -орбите радиуса r_n , $\hbar = h / (2\pi)$

Второй постулат Бора (правило частот): при переходе электрона с одной стационарной орбиты

переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую излучается (поглощается) один фотон с энергией $h\nu = E_n - E_m$ равной разности энергий соответствующих стационарных состояний (E_n и E_m – соответственно энергии стационарных состояний атома до и после излучения (поглощения)). При $E_m < E_n$ происходит излучение фотона, при $E_m > E_n$ – его поглощение.

Билет 10

2. Примесная проводимость полупроводников.

Концентрация основных и неосновных носителей в

2. Примесная проводимость полупроводников.

Концентрация основных и неосновных носителей в полупроводнике p-типа. Уровень Ферми примесного полупроводника p-типа.

Проводимость, обусловленная примесями, называется примесной, а сами полупроводники – примесными. В полупроводниках с примесью, валентность которой на единицу меньше валентности основных атомов, носителями тока являются дырки; возникает дырочная проводимость (проводимость p-типа). Примеси, захватывающие электроны из валентной зоны полупроводника, называются акцепторами, а энергетические уровни этих примесей –

энергетические уровни этих примесей – акцепторными.

Уровень Ферми при 0К располагается посередине между потолком валентной зоны и акцепторным уровнем.

Проводимость примесного полупроводника определяется концентрацией носителей и их подвижностью. С изменением температуры

подвижность носителей меняется по сравнительно слабому степенному закону, а концентрация носителей – по очень сильному

экспоненциальному закону, поэтому проводимость примесных полупроводников от температуры определяется в основном температурной

зависимостью концентрации носителей тока в

Бюджет 10

Три увеличенными периодичности. темп T амт
в $\eta = 2$ раза длина волны λ_m , на которую
приходится максимум спектральной плотности
энергетической светимости, уменьшая на
 $\Delta \lambda = 400 \text{ нм}$. Определить начальную и конечную
температуры тела T_1 и T_2

Дано:

Решение

$$\frac{T_2}{T_1} = 2$$

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

$$b = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$$

Dano:

$$\frac{T_2}{T_1} = 2$$

$$\Delta \lambda = 400 \text{ nm}$$

T_1, T_2

Решение

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

$$b = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$$

$$\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{b}{T_1} - \frac{b}{T_2} = \frac{b}{T_1} - \frac{b}{2T_1} =$$

$$= \frac{b}{2T_1}$$

$$T_1 = \frac{b}{2\Delta \lambda}$$

$$T_2 = 2 \cdot T_1$$